1000–12000 MHz GaN SPDT MMIC スイッチ・ベアダイ

LCI-SW-1000-12000-SPDT — 1000–12000 MHz GaN SPDT MMIC スイッチ・ベアダイ.

挿入損失: 1 dB (標準値); アイソレーション: 34 dB (最小値) / 63 dB (最大値); 入力0.2 dB圧縮点電力: 43 dBm (標準値). ダイ寸法: 2.45 × 1.2 × 0.1 mm.



RF 特性 TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	-	1000	-	12000	MHz
挿入損失	-	-	1	-	dB
アイソレーション	-	34	-	63	dB
入力0.2 dB圧縮点電力	-	-	43	-	dBm
スイッチング時間	-	-	10	-	ns

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値
制御電圧	-	-	-	-	V1 = -28 V; V2 = 0 V (RFC ↔ RF1)
制御電圧	-	-	-	-	V1 = 0 V; V2 = -28 V (RFC ↔ RF2)

絶対限界値

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
ゲート・バイアス下限	-	-60	-	-	V
最大入力電力	-	-	-	43	dBm

環境仕様

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
保存温度	-	-65	-	150	°C
動作温度	-	-55	-	85	°C

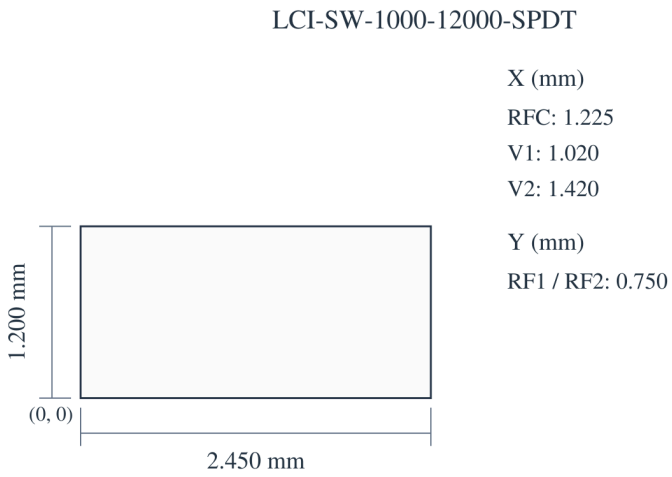
ボンディングパッド配置

ピン番号	記号	mm
1	RFC	0.120 × 0.080
2, 3	RF1, RF2	0.120 × 0.080
4, 5	V1, V2	0.100 × 0.100

ダイ寸法

項目	値	単位
ダイ寸法	2.45 × 1.2 × 0.1	mm

外形および寸法が示された座標の参照図です。寸法の単位は mm です。製造およびワイヤボンディングには、それぞれの詳細図面が必要です。



2.450 × 1.200 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

現在の発行記録 · 1.7 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.6.

ダイ実装とバイアスの印加順序

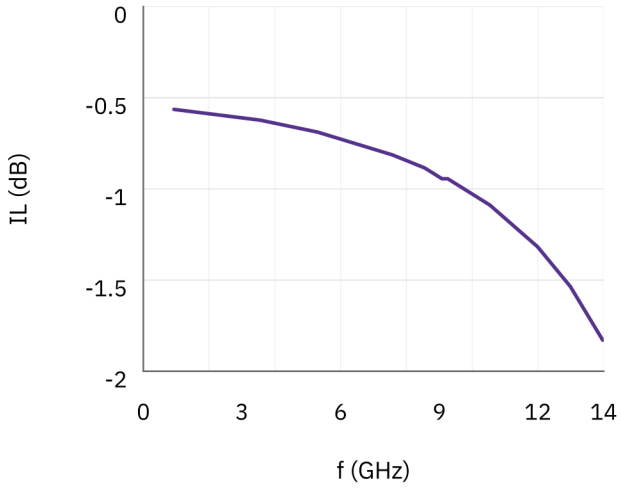
RF ポートに外付け DC ブロック・コンデンサは不要です。 ダイのゲート制御は0/−28 Vです。TTL制御には外付けドライバが必要です。

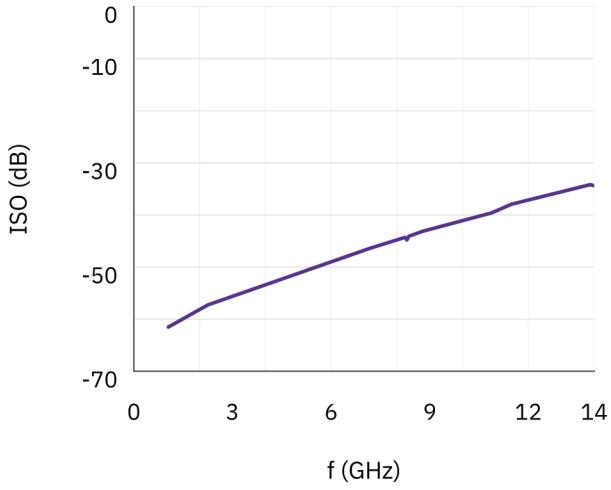
性能特性曲線

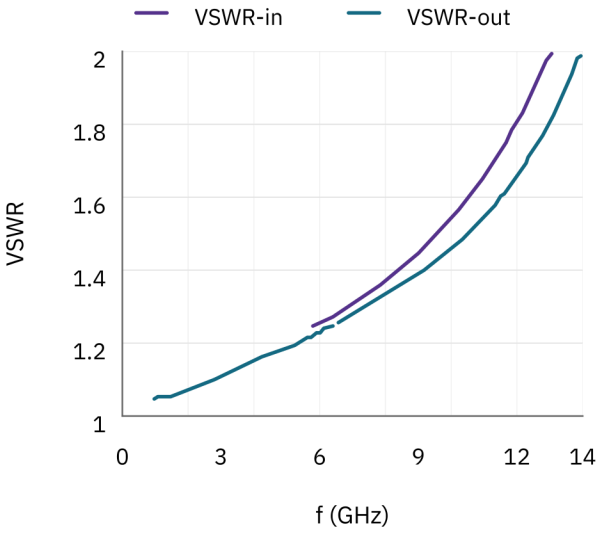
各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。

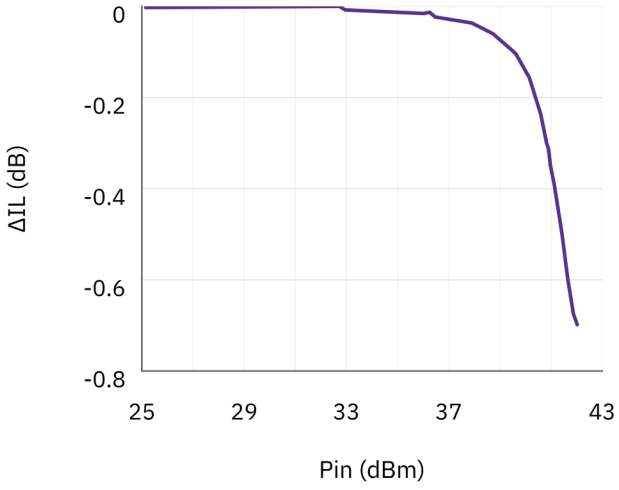
入出力整合、アイソレーション、挿入損失、ΔIL (dB)。

図の注記：TA=+25°C。 読み取り値は近似値です。 f = 6 GHz; Pin = 25–43 dBm. IL と ISO は符号付き dB 値です。圧縮特性は 6 GHz における Pin に対する ΔIL です。1 dB のしきい値は規定していません。









文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。